This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年7 月26 日 (26.07.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/53766 A1

(51) 国際特許分類7:

F26B 21/04, H01L 21/304

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/00175

(22) 国際出願日:

2000年1月17日(17.01.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の宮語:

日本語

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東邦 化成株式会社 (TOHO KASEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 639-1031 奈良県大和郡山市今国府町6-2 Nara (JP). ダ イキン工業株式会社 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒530-8323 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4 番12号 梅田センタービル Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 前田徳雄 (MAEDA, Norio) [JP/JP]. 鷲見孝治 (SUMI, Koji)

[JP/JP]; 〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町6-2 東邦化成株式会社内 Nara (JP). 粟飯原大 (AIHARA, Hiroshi) [JP/JP]. 大野正雄 (OONO, Masao) [JP/JP]. 松本隆夫 (MATSUMOTO, Takao) [JP/JP]. 泉谷直昭 (IZUTANI, Naoaki) [JP/JP]; 〒591-8022 大阪府堺市金 岡町1304番地 ダイキン工業株式会社 堺製作所 金岡 工場内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 弁理士 津川友士(TSUGAWA, Tomoo); 〒 536-0005 大阪府大阪市城東区中央2丁目7番7号 ライオンズマンション野江1201号 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

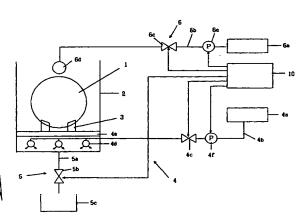
添付公開書類:

— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DRYING SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 基板乾燥方法およびその装置



(57) Abstract: A substrate drying device, comprising a treatment chamber (2) storing a specified number of substrates (1) such as semiconductor wafers installed erectedly in parallel with each other, a first substrate supporting part (3) supporting substrates (1) inside the treatment chamber (2), a treatment liquid feed part (4) feeding, to the treatment chamber (2), the treatment liquid for performing a treatment such as a cleaning treatment on the substrates (1), a delivery part (5) delivering treatment liquid from the treatment chamber (2), and a fluid feed part for drying (6) feeding, to the treatment chamber (2), the fluid drops of drying fluid for performing drying treatment on the substrates (1).

(57) 要約:

半導体ウエハーなどの基板1を所定枚数だけ互いに平行に立設させた状態で収容する処理槽2と、処理槽2の内部において基板1を支承する第1基板支承部3と、基板1に対する洗浄処理などの処理を行うための処理液を処理槽2に供給する処理液供給部4と、処理槽2から処理液を排出する排出部5と、基板1に対する乾燥処理を行うための乾燥用流体の液滴を処理槽2に供給する乾燥用流体供給部6とを有している。

WO 01/53766 A1

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

基板乾燥方法およびその装置

5 技術分野

この発明は基板乾燥方法およびその装置に関し、さらに詳細にいえば、洗浄液を用いて洗浄された基板を迅速に乾燥させるための方法およびその装置に関する。

10 背景技術

15

20

従来から、洗浄液を用いて基板(例えば、半導体ウエハーなど)を洗浄した後に、洗浄液の液面を基板に対して相対的に下降させながら乾燥用流体蒸気 {例えば、イソプロピルアルコール(以下、IPAと略称する)蒸気など}を供給して基板を乾燥させる装置として、特公平6-103686号公報、米国特許第5,964,958号などに示す構成のものが提案されている。

これらの装置を採用した場合には、処理槽内に収容した複数枚の基板を洗浄液によって洗浄した後、洗浄液の液面を下降させながら処理槽内に乾燥用流体蒸気を導入し、洗浄液の液面上に薄い乾燥用流体の液層を作製し、マランゴニ効果を利用して基板の表面を迅速に乾燥させることができる。

特公平6-103686号公報に示す構成の装置を採用した場合には、処理槽内において乾燥用蒸気の流れを形成するために、乾燥用蒸気を導入する導入流路のみならず、乾燥用蒸気を排出するための逃がし弁(排気口)が必要になり、構成が複雑化するとともに、工場内へ乾燥用蒸気が漏出するという危険性がある。

25 また、半導体ウエハーの乾燥に適用する場合において、近年は半導体ウエハーが 大型化するとともに、同時処理される半導体ウエハーの数を増加させるべく半導体

20

25

ウエハーどうしの間隔を小さくすることが要求されているのであるが、このような 場合には、乾燥用蒸気が半導体ウエハーどうしの間に侵入しにくくなり、ひいては 半導体ウエハーに乾燥むらが発生するという不都合がある。

さらに、半導体ウエハーなどの基板がその表面にある程度の厚みのパターンを有 している場合には、パターンの内部(凹入部)まで十分に迅速に乾燥させるために は乾燥用流体の液層の厚みをかなり大きくしなければならないのであるが、基板の 全表面において乾燥用流体の液層の厚みを十分に大きくすることが困難であるから、 パターンの内部を十分には乾燥させることができず、ひいては洗浄液が基板の表面 に残留してしまう。換言すれば、高アスペクト化された基板に対しては十分には対 10 応することができない。

発明の開示

この発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、排気設備を省略し、もし くは簡略化することができ、しかも乾燥用流体の供給をスムーズに行うことができ 15 るとともに、乾燥用流体の液層の厚みを十分に大きくすることができる基板乾燥方 法およびその装置を提供することを目的としている。

請求項1の基板乾燥方法は、処理槽内に基板を収容し、かつ処理槽内における洗 浄液の液面を基板に対して相対的に下降させながら処理槽内に乾燥用流体を供給す ることにより基板の表面を乾燥させるに当たって、

乾燥用流体を液の状態で処理槽内に導入し、ノズルを用いて乾燥用流体の液滴を 形成して洗浄液面上に供給する方法である。

この場合において、乾燥用流体の液滴は、粒径が100μmより大きく、かつ1 mm以下であることが好ましく、粒径が100μmより大きく、かつ200μm以 下であることが一層好ましい。

請求項2の基板乾燥方法は、処理槽内において基板を所定角度だけ傾斜させた状

態で収容し、ノズルを用いて傾斜された基板の向きと同じ方向に乾燥用流体の液滴 を供給する方法である。

この場合において、傾斜角度が0°より大きく、かつ30°以下であることが好ましく、3°以上、かつ5°以下であることが一層好ましい。

5 請求項3の基板乾燥方法は、洗浄液の液面における基板の全幅にわたって乾燥用 流体が広がるように、乾燥用流体の処理槽内への導入に方向性を持たせるとともに、 乾燥用流体の導入初速を設定する方法である。

この場合において、導入初速は、 $10\,\text{m/sec以上}$ 、かつ $330\,\text{m/sec以}$ 下であることが好ましく、 $50\,\text{m/sec以}$ 上、かつ $150\,\text{m/sec以}$ 下である

請求項4の基板乾燥方法は、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽に不活性ガスを供給する方法である。

請求項5の基板乾燥方法は、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽への乾燥用流体および/または不活性ガスの供給量を増加させる方法である。

15 請求項6の基板乾燥方法は、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、基板の支承位 置を変化させる方法である。

請求項7の基板乾燥方法は、洗浄液の排出前に処理槽内を不活性ガス雰囲気に設定する方法である。

請求項8の基板乾燥方法は、洗浄工程およびその後の乾燥工程を室温で行う方法 20 である。

請求項9の基板乾燥方法は、ノズルに供給される不活性ガスにより乾燥用流体を 圧送する方法である。

請求項10の基板乾燥装置は、処理槽内において支承手段によって基板を支承し、かつ処理槽内における洗浄液の液面を基板に対して相対的に下降させながら処理槽内に乾燥用流体を供給することにより基板の表面を乾燥させるものであって、

乾燥用流体を液の状態で処理槽内に導入し、ノズルを用いて乾燥用流体の液滴を

形成して洗浄液面上に供給する乾燥用流体供給手段を含むものである。

この場合において、乾燥用流体の液滴は、粒径が 100μ mより大きく、かつ1mm以下であることが好ましく、粒径 100μ mより大きく、かつ 200μ m以下であることが一層好ましい。

5 請求項11の基板乾燥装置は、前記支承手段として、処理槽内において基板を所 定角度だけ傾斜させた状態で支承するものを採用し、前記ノズルとして、傾斜され た基板の向きと同じ方向に乾燥用流体の液滴を供給するものを採用するものである。 この場合において、傾斜角度が0°より大きく、かつ30°以下であることが好 ましく、3°以上、かつ5°以下であることが一層好ましい。

10 請求項12の基板乾燥装置は、前記乾燥用流体供給手段として、洗浄液の液面における基板の全幅にわたって乾燥用流体が広がるように、乾燥用流体の処理槽内への導入に方向性を持たせるとともに、乾燥用流体の導入初速を設定するものを採用するものである。

この場合において、導入初速は、 $10\,\text{m/sec以上}$ 、かつ $330\,\text{m/sec以}$ 15 下であることが好ましく、 $50\,\text{m/sec以}$ 上、かつ $150\,\text{m/sec以}$ 下であることが一層好ましい。

請求項13の基板乾燥装置は、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽に不活性ガスを供給する不活性ガス供給手段をさらに含むものである。

請求項14の基板乾燥装置は、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽への 20 乾燥用流体および/または不活性ガスの供給量を増加させる供給量制御手段をさら に含むものである。

請求項15の基板乾燥装置は、前記支承手段として、基板支承箇所に対して下向 きに連続して洗浄液導入用溝を有するものを採用するものである。

請求項16の基板乾燥装置は、前記支承手段として、基板の互いに異なる位置を 25 選択的に支承する1対の支承手段を採用し、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、 支承手段による基板の支承位置を変化させる支承位置制御手段をさらに含むもので ある。

請求項17の基板乾燥装置は、洗浄液の排出前に処理槽内を不活性ガス雰囲気に 設定する雰囲気設定手段をさらに含むものである。

請求項18の基板乾燥装置は、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、ノズルを基 5 板に接近させるノズル位置制御手段をさらに含むものである。

この場合において、ノズル位置制御手段によるノズルの可動範囲は、0mmよりも大きく、かつ500mm以下であることが好ましく、250mm以上、かつ350mm以下であることが一層好ましい。

請求項19の基板乾燥装置は、非噴出時に乾燥用流体を循環させる循環手段をさ 10 らに含むものである。

請求項20の基板乾燥装置は、ノズルの設置個数を基板サイズ、基板ピッチに応じて設定するものである。

請求項21の基板乾燥装置は、ノズルとして、同時に乾燥されるべき基板の枚数よりも1つだけ多い数の乾燥用流体噴出孔を有するものを採用するものである。

15 請求項22の基板乾燥装置は、乾燥用流体を圧送すべくノズルに不活性ガスを供給する不活性ガス供給手段をさらに含むものである。

請求項1の基板乾燥方法であれば、処理槽内に基板を収容し、かつ処理槽内における洗浄液の液面を基板に対して相対的に下降させながら処理槽内に乾燥用流体を供給することにより基板の表面を乾燥させるに当たって、

20 乾燥用流体を液の状態で処理槽内に導入し、ノズルを用いて乾燥用流体の液滴を 形成して洗浄液面上に供給するのであるから、液状の乾燥用流体の自重の影響を受けて、乾燥用流体の液滴を基板どうしの間にスムーズに導入し、蒸気供給に比べて 高濃度の乾燥用流体を供給できるのでマランゴニ効果が大きく、洗浄液面上に十分 な厚みの乾燥用流体の液層を作製して、マランゴニ効果を利用した迅速、かつ、む 5の著しく少ない乾燥を達成することができる。そして、乾燥用流体の液層の厚み を十分に大きくできるので、基板がパターンを有している場合であっても、パター

15



ンの内部(凹入部)まで確実な乾燥を達成して、高アスペクト化への対応を可能にすることができ、洗浄用流体が基板の表面に残留することを確実に防止することができる。また、乾燥用流体を液滴の状態で供給しているので、乾燥用流体の全部または殆どを洗浄液と共に排出することができ、乾燥用流体の漏出のおそれを殆ど皆無にして、排気設備を省略し、もしくは簡略化することができ、ひいてはコストダウンを達成することができる。

この場合において、乾燥用流体の液滴が、粒径が100μmより大きく、かつ1 mm以下であれば液滴の供給に伴う上記の作用を達成することができる。ただし、粒径を100μmより大きく、かつ200μm以下にすることが一層好ましく、供給量が不足して乾燥が不十分になるという不都合の発生、洗浄液を跳ねて基板に洗浄液が付着するという不都合の発生、乾燥用流体の使用量が多くなってランニングコストが増大するという不都合の発生を防止することができる。

請求項2の基板乾燥方法であれば、処理槽内において基板を所定角度だけ傾斜させた状態で収容し、ノズルを用いて傾斜された基板の向きと同じ方向に乾燥用流体の液滴を供給するのであるから、基板が一方の面にパターンを有しているとともに、複数枚の基板のパターン形成面が同じ側に位置している場合に、パターンの内部に入り込んだ洗浄用流体の排出を容易にして、一層迅速、かつ良好な乾燥を達成することができる。

この場合において、傾斜角度が 0° より大きく、かつ 3 0° 以下であれば、上記 00 作用を達成することができる。ただし、傾斜角度が 3° 以上、かつ 5° 以下であることが一層好ましく、パターンの内部の洗浄液が排出されにくいという不都合の発生、乾燥用流体を浸漬界面に供給するのが困難になるという不都合の発生、パターンから排出された洗浄液が隣の基板に滴下するという不都合の発生を防止することができるほか、上記の作用を達成することができる。

25 請求項3の基板乾燥方法であれば、洗浄液の液面における基板の全幅にわたって 乾燥用流体が広がるように、乾燥用流体の処理槽内への導入に方向性を持たせると

ともに、乾燥用流体の導入初速を設定するのであるから、基板が大径化し、および / または基板どうしの間隔が小さくなった場合であっても、基板どうしの間隙に乾燥用流体の液滴をスムーズに供給することができ、洗浄液の液面上に乾燥用流体の液層を形成し続けることができ、ひいては、迅速、かつ、むらのない基板の乾燥を達成することができる。また、乾燥用流体の濃度を必要以上に高める必要がないのみならず、乾燥用流体の温度を必要以上に高める必要もないのであるから、ランニングコストを低減することができるとともに、乾燥用流体の引火性に起因して空気と混合すると爆発性を持つのであるが、この爆発性を抑制することができ、安全性の面でも有益となる。

10 この場合において、導入初速が10m/sec以上、かつ330m/sec以下であれば上記の作用を達成することができる。ただし、導入初速が120m/sec以上、かつ220m/sec以下であることが一層好ましく、基板どうしの間隙に乾燥用流体の液滴をスムーズに供給することができないという不都合の発生、洗浄液などの液面揺れが大きくなって、マランゴニ乾燥の最適速度よりも実質的に大きな速度になり、洗浄液が基板面上に残留するという不都合の発生を防止することができる。

請求項4の基板乾燥方法であれば、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽に不活性ガスを供給するのであるから、洗浄液の排出に伴って処理槽内が負圧になり、外部から不純物が侵入することを防止することができる。

- 20 請求項5の基板乾燥方法であれば、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽への乾燥用流体および/または不活性ガスの供給量を増加させるのであるから、洗浄液の排出に供給量を増加させて洗浄液の液面まで乾燥用流体の液滴を確実に供給して、洗浄液の液面における乾燥用流体の液層を所定厚み以上に維持し続けることができる。
- 25 請求項6の基板乾燥方法であれば、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、基板の 支承位置を変化させるのであるから、基板の支承位置をも迅速、かつ確実に乾燥さ

せることができる。

請求項7の基板乾燥方法であれば、洗浄液の排出前に処理槽内を不活性ガス雰囲気に設定するのであるから、基板の表面にウォーターマークが発生することを大幅に抑制することができる。

5 請求項8の基板乾燥方法であれば、洗浄工程およびその後の乾燥工程を室温で行 うのであるから、加熱処理が不要であり、システム全体としての構成の簡略化を達 成することができるとともに、安全性を高めることができる。

請求項9の基板乾燥方法であれば、ノズルに供給される不活性ガスにより乾燥用 流体を圧送するのであるから、乾燥用流体を供給するための駆動部が不要となり、 不純物の混入を防止して清浄性を高めることができる。

請求項10の基板乾燥装置であれば、処理槽内において支承手段によって基板を 支承し、かつ処理槽内における洗浄液の液面を基板に対して相対的に下降させなが ら処理槽内に乾燥用流体を供給することにより基板の表面を乾燥させるに当たって、

乾燥用流体供給手段によって、乾燥用流体を液の状態で処理槽内に導入し、ノズ 15 ルを用いて乾燥用流体の液滴を形成して洗浄液面上に供給することができる。

したがって、液状の乾燥用流体の自重の影響を受けて、乾燥用流体の液滴を基板 どうしの間にスムーズに導入し、蒸気供給に比べて高濃度の乾燥用流体を供給でき るのでマランゴニ効果が大きく、洗浄液面上に十分な厚みの乾燥用流体の液層を作 製して、マランゴニ効果を利用した迅速、かつ、むらの著しく少ない乾燥を達成す 3ことができる。そして、乾燥用流体の液層の厚みを十分にできるので、基板がパ ターンを有している場合であっても、パターンの内部(凹入部)まで確実な乾燥を 達成して、高アスペクト化への対応を可能にすることができ、洗浄用流体が基板の 表面に残留することを確実に防止することができる。また、乾燥用流体を液滴の状 態で供給しているので、乾燥用流体の全部または殆どを洗浄液と共に排出すること ができ、乾燥用流体の漏出のおそれを殆ど皆無にして、排気設備を省略し、もしく は簡略化することができ、ひいてはコストダウンを達成することができる。



10

15

この場合において、乾燥用流体の液滴が、粒径が 100μ mより大きく、かつ1mm以下であれば液滴の供給に伴う上記の作用を達成することができる。ただし、粒径を 100μ mより大きく、かつ 200μ m以下にすることが一層好ましく、供給量が不足して乾燥が不十分になるという不都合の発生、洗浄液を跳ねて基板に洗浄液が付着するという不都合の発生、乾燥用流体の使用量が多くなってランニングコストが増大するという不都合の発生を防止することができる。

請求項11の基板乾燥装置であれば、前記支承手段として、処理槽内において基板を所定角度だけ傾斜させた状態で支承するものを採用し、前記ノズルとして、傾斜された基板の向きと同じ方向に乾燥用流体の液滴を供給するものを採用しているので、基板が一方の面にパターンを有しているとともに、複数枚の基板のパターン形成面が同じ側に位置している場合に、パターンの内部に入り込んだ洗浄用流体の排出を容易にして、一層迅速、かつ良好な乾燥を達成することができる。

この場合において、傾斜角度が0°より大きく、かつ30°以下であれば、上記の作用を達成することができる。ただし、傾斜角度が3°以上、かつ5°以下であることが一層好ましく、パターンの内部の洗浄液が排出されにくいという不都合の発生、乾燥用流体を浸漬界面に供給するのが困難になるという不都合の発生、パターンから排出された洗浄液が隣の基板に滴下するという不都合の発生を防止することができる。

請求項12の基板乾燥装置であれば、前記乾燥用流体供給手段として、洗浄液の 液面における基板の全幅にわたって乾燥用流体が広がるように、乾燥用流体の処理 槽内への導入に方向性を持たせるとともに、乾燥用流体の導入初速を設定するもの を採用しているので、基板が大径化し、および/または基板どうしの間隔が小さく なった場合であっても、基板どうしの間隙に乾燥用流体の液滴をスムーズに供給す ることができ、洗浄液の液面上に乾燥用流体の液層を形成し続けることができ、ひ いては、迅速、かつ、むらのない基板の乾燥を達成することができる。また、乾燥 用流体の濃度を必要以上に高める必要がないのみならず、乾燥用流体の温度を必要

10



以上に高める必要もないのであるから、ランニングコストを低減することができるとともに、乾燥用流体の引火性に起因して空気と混合すると爆発性を持つのであるが、この爆発性を抑制することができ、安全性の面でも有益となる。

- 10 -

この場合において、導入初速が10m/sec以上、かつ330m/sec以下であれば上記の作用を達成することができる。ただし、導入初速が120m/sec以上、かつ220m/sec以下であることが一層好ましく、基板どうしの間隙に乾燥用流体の液滴をスムーズに供給することができないという不都合の発生、洗浄液などの液面揺れが大きくなって、マランゴニ乾燥の最適速度よりも実質的に大きな速度になり、洗浄液が基板面上に残留するという不都合の発生を防止することができる。

請求項13の基板乾燥装置であれば、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽に不活性ガスを供給する不活性ガス供給手段をさらに含むのであるから、洗浄液の排出に伴って処理槽内が負圧になり、外部から不純物が侵入することを防止することができる。

- 15 請求項14の基板乾燥装置であれば、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽への乾燥用流体および/または不活性ガスの供給量を増加させる供給量制御手段をさらに含むのであるから、洗浄液の排出に供給量を増加させて洗浄液の液面まで乾燥用流体の液滴を確実に供給して、洗浄液の液面における乾燥用流体の液層を所定厚み以上に維持し続けることができる。
- 20 請求項15の基板乾燥装置であれば、前記支承手段として、基板支承箇所に対して下向きに連続して洗浄液導入用溝を有するものを採用するのであるから、基板支承箇所における洗浄液切れ性を向上させることができる。

請求項16の基板乾燥装置であれば、前記支承手段として、基板の互いに異なる 位置を選択的に支承する1対の支承手段を採用し、洗浄液の処理槽からの排出に伴 って、支承手段による基板の支承位置を変化させる支承位置制御手段をさらに含む のであるから、基板の支承位置をも迅速、かつ確実に乾燥させることができる。

25

請求項17の基板乾燥装置であれば、洗浄液の排出前に処理槽内を不活性ガス雰囲気に設定する雰囲気設定手段をさらに含むのであるから、基板の表面にウォーターマークが発生することを大幅に抑制することができる。

請求項18の基板乾燥装置であれば、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、ノズルを基板に接近させるノズル位置制御手段をさらに含むのであるから、乾燥用流体の液滴の導入初速、導入流量を変化させることなく、洗浄液の液面に十分な量の乾燥用流体を供給することができる。

この場合において、ノズル位置制御手段によるノズルの可動範囲は、0mmよりも大きく、かつ500mm以下であることが好ましく、上記の作用を達成することができる。ただし、ノズルの可動範囲が250mm以上、かつ350mm以下であることが一層好ましく、洗浄液の液面揺れが大きくなって、マランゴニ乾燥の最適速度よりも実質的に大きな速度になり、洗浄液が基板面上に残留するという不都合の発生、基板の隙間に乾燥用流体が入り込まないという不都合の発生を防止することができる。

15 請求項19の基板乾燥装置であれば、非噴出時に乾燥用流体を循環させる循環手段をさらに含むのであるから、乾燥用流体が存在する空間を常に外部圧力よりも高くして外部からの不純物の侵入を防止することができるとともに、乾燥用流体の使用量を削減してランニングコストを低減することができる。

請求項20の基板乾燥装置であれば、ノズルの設置個数を基板サイズ、基板ピッ 20 手に応じて設定するのであるから、基板の全面においてむらのない乾燥を達成する ことができる。

請求項21の基板乾燥装置であれば、ノズルとして、同時に乾燥されるべき基板の枚数よりも1つだけ多い数の乾燥用流体噴出孔を有するものを採用するのであるから、乾燥用流体を基板どうしの間隙の全ておよび最も端部の基板の外側に乾燥用流体の液滴を供給して、基板の全表面を迅速に、かつむらなく乾燥させることができる。

請求項22の基板乾燥装置であれば、乾燥用流体を圧送すべくノズルに不活性ガスを供給する不活性ガス供給手段をさらに含むのであるから、乾燥用流体を供給するための駆動部が不要となり、不純物の混入を防止して清浄性を高めることができる。

5

図面の簡単な説明

第1図はこの発明の基板乾燥方法が適用される基板処理装置の一構成例を示す概略図である。

- 10 第2図は第1基板支承部の構成を示す拡大縦断面図である。
 - 第3図は基板処理装置の他の構成例の要部を示す概略図である。
 - 第4図は基板処理装置のさらに他の構成例の要部を示す概略図である。
 - 第5図は基板処理装置のさらに他の構成例を示す概略図である。
 - 第6図は基板処理装置のさらに他の構成例の要部を示す概略図である。
- 15 第7図は乾燥用流体ノズルの下降状態を示す概略図である。
 - 第8図は基板処理装置のさらに他の構成例の要部を示す概略図である。
 - 第9図は洗浄液減少状態を示す概略縦断面図である。
 - 第10図は基板受け渡し動作状態を示す概略縦断面図である。
 - 第11図は基板受け渡し後の状態を示す概略縦断面図である。
- 20 第12図は基板処理装置のさらに他の構成例の要部を示す概略図である。
 - 第13図は第12図の基板処理装置に適用される基板を示す拡大縦断面図である。
 - 第14図は基板処理装置のさらに他の構成例の要部を示す概略図である。
- 25 発明を実施するための最良の形態

以下、添付図面を参照して、この発明の基板乾燥方法およびその装置の実施態様を詳細に説明する。

第1図はこの発明の基板乾燥方法が適用される基板処理装置の一構成例を示す概略図である。

5 この基板乾燥装置は、半導体ウエハーなどの基板1を所定枚数だけ互いに平行に立設させた状態で収容する処理槽2と、処理槽2の内部において基板1を支承する第1基板支承部3と、基板1に対する洗浄処理などの処理を行うための処理液(例えば、洗浄処理を行う場合であれば、純水、脱イオン水、脱酸素水など)11を処理槽2に供給する処理液供給部4と、処理槽2から処理液11を排出する排出部5と、基板1に対する乾燥処理を行うための乾燥用流体の液滴12を処理槽2に供給する乾燥用流体供給部6とを有している。そして、処理液供給部4、排出部5、および乾燥用流体供給部6の動作を制御する、マイコンなどからなる制御部10を有している。

前記第1基板支承部3は、第2図に示すように、本体部材3aの上面に断面V字 北の複数個の支承溝3bを形成してなるものである。ただし、第2図中に破線で示すように、各支承溝3bの底部から下方に延びるスリット3cを設けて水切れ性を向上させることが好ましく、スリット3cの下端部に連続させて丸穴3dを設けて処理液切れ性をさらに向上させることが一層好ましい。

前記処理液供給部4は、処理液タンク4aと、処理液タンク4aから処理液11 20 を導出する処理液供給管路4bと、処理液供給管路4bの所定位置に設けられた開 閉弁4cおよびポンプ4fと、処理液供給管路4bを通して供給される処理液11 を処理槽2内に噴出させる処理液ノズル4dと、処理液ノズル4dから噴出された 処理液11を整流して、処理槽2に収容された基板1に向かって供給する整流板4 eとを有している。

25 前記排出部5は、処理槽2の底部の所定位置に設けられた排出管5aと、排出管5aの所定位置に設けられた開閉弁5bと、排出管5aを通して排出された処理液

11を収容する廃液タンク5cとを有している。

前記乾燥用流体供給部6は、イソプロピルアルコール(IPA)、エチルアルコ ール、メチルアルコール、テトラハイドロフラン、アセトン、パーフルオロヘキサ ン、もしくはヘキサンなどの実質的な非反応液体からなる乾燥用流体(処理液より も表面張力が小さい流体)を収容する乾燥用流体タンク6aと、乾燥用流体タンク 5 6 a から乾燥用流体を導出する乾燥用流体供給管路 6 b と、乾燥用流体供給管路 6 b の所定位置に設けられた開閉弁6 c およびポンプ6 e と、乾燥用流体供給管路6 b を通して供給される乾燥用流体を液滴12として処理槽2内に噴出させる乾燥用 流体ノズル6dとを有している。なお、乾燥用流体ノズル6dは、液滴12の粒径 が100μmよりも大きく、かつ1mm以下となるように液滴噴出口の口径などが 10 設定されていればよいが、液滴12の粒径が100μmよりも大きく、かつ200 μm以下となるように液滴噴出口の口径などが設定されていることが好ましい。液 滴12の粒径をこのように設定すれば、供給量が不足して乾燥が不十分になるとい う不都合の発生、洗浄液を跳ねて基板に洗浄液が付着するという不都合の発生、乾 燥用流体の使用量が多くなってランニングコストが増大するという不都合の発生を 15 防止することができる。また、乾燥用流体ノズル6dからの液滴12の噴出速度が 10m/sec以上、かつ330m/sec以下になるように、乾燥用流体ノズル 6 d の内径、液滴噴出口の口径などが設定されていればよいが、液滴12の噴出速 度が120m/sec以上、かつ220m/sec以下になるように、乾燥用流体 ノズル6dの内径、液滴噴出口の口径などが設定されていることが好ましい。液滴 20 12の噴出速度をこのように設定すれば、基板どうしの間隙に乾燥用流体の液滴を スムーズに供給することができないという不都合の発生、洗浄液などの液面揺れが 大きくなって、マランゴニ乾燥の最適速度よりも実質的に大きな速度になり、洗浄 液が基板面上に残留するという不都合の発生を防止することができる。さらに、乾 燥用流体の流量が0.1cc/min以上、かつ20cc/minになるように、 25 乾燥用流体供給管路6bの内径などが設定されていればよいが、乾燥用流体の流量

15

が 0. 5 c c / min以上、かつ2 c c / minになるように、乾燥用流体供給管路6 b の内径などが設定されていることが好ましい。さらにまた、乾燥用流体ノズル6 d から基板1までの距離が0 mmよりも大きく、かつ500 mm以下であればよいが、50 mm以上、かつ150 mm以下であることが好ましい。乾燥用流体ノズル6 d から基板1までの距離をこのように設定すれば、洗浄液の液面揺れが大きくなって、マランゴニ乾燥の最適速度よりも実質的に大きな速度になり、洗浄液が基板面上に残留するという不都合の発生、基板の隙間に乾燥用流体が入り込まないという不都合の発生を防止することができる。ただし、ポンプ6 e を設ける代わりに、乾燥用流体ノズル6 d に不活性ガスを供給して乾燥用流体を乾燥用流体供給管路6 b を通して吸引し、吸引された乾燥用流体を不活性ガスと共に液滴として噴出させるようにしてもよい。この場合には、ポンプ6 e の駆動部に起因する不純物の発生を防止することができる。

なお、乾燥用流体ノズル6dとしては、フッ素樹脂などの耐薬品性物質 {好ましくは、PFA、PCTFE、PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) など} からなるものを採用することが好ましく、フッ酸雰囲気中でも腐食を防止することができる。

上記の構成の基板処理装置の作用は次のとおりである。

全ての基板1の全表面をほぼ均一に処理することができる。

先ず、制御部10により、開閉弁5b、6cを閉じ、開閉弁4cを開くとともに、ポンプ4fを動作させる。この状態においては、処理液タンク4aから処理液11 が処理液供給管路4bを通して処理液ノズル4dに供給され、処理液ノズル4dから処理槽2内に噴出される。そして、処理槽2内に噴出された処理液11は、整流板4eにより整流されて基板収容空間に導かれ、基板1の表面に対する処理(例えば、洗浄処理など)を行うことができる。なお、この処理を行う間において、処理槽2からオーバーフローする処理液11は、図示しない回収機構により回収される。 また、基板1の中心に対応する処理液11の流速を最も速く設定することにより、

10

15

20

な乾燥を達成することができる。

処理液11による基板1の処理が終了した後は、制御部10により、開閉弁4cを閉じ、開閉弁5b、6cを開くとともに、ポンプ6eを動作させる。この状態においては、処理槽2から排出管5aを通して処理液11が排出され、処理液11の液面が徐々に下降する。また、同時に、乾燥用流体タンク6aから乾燥用流体供給管路6bを通して乾燥用流体が乾燥用流体ノズル6dに供給され、乾燥用流体ノズル6dが砂塊で供給される。大型にで、水型でで、水型でで、水型でで、水型でで、水型でが、水の比較的厚い膜厚に形成される。換言すれば、乾燥用流体が噴霧により供給される場合には、乾燥用流体の粒径が100μm以下であるから、基板1どうしの間隔が小さい状態において基板1の中心部乃至下部にまで乾燥用流体を供給することが困難であり、ひいては、乾燥用流体の液層の膜厚を大きくすることが困難である。しかし、この実施態様においては、乾燥用流体を液滴12の状態で供給するようにしているので、基板1どうしの間隔が小さい状態であっても基板1の中心部乃至下部にまで乾燥用流体を供給するようにしているので、基板1どうしの間隔が小さい状態であっても基板1の中心部乃至下部にまで乾燥用流体を供給することが可能であり、ひいては、乾燥用流体の液層の膜厚を大きくすることが可能になり、基板1の良好

そして、処理液11の液面が徐々に下降することに伴って、基板1が徐々に処理液11の液面から露出するが、基板1の露呈部分には乾燥用流体の液層が形成されるので、マランゴニ効果によって迅速に、かつむらなく露出部分を乾燥させることができる。

したがって、最終的に基板1の全表面をマランゴニ効果によって迅速に、かつむらなく露出部分を乾燥させることができる。もちろん、処理液11が基板1の表面に残留することを防止することができる。

ただし、基板1の表面のうち、第1基板支承部3の支承溝3bにより支承されて 25 いる部分は、第1基板支承部3と接触しているとともに、基板1の下方に微小な空 間が存在しているので、この部分の乾燥が不十分(乾燥の程度、乾燥所要時間が不

十分)になる可能性がある。 しかし、支承溝 3 b に連続させてスリット 3 c を形成し、必要に応じてさらに丸穴 3 d を形成している場合には、スリット 3 c 、丸穴 3 d によって処理液切れ性を向上させることができるので、上記の部分の乾燥を十分にすることができる。

5 また、この実施態様を採用した場合には、乾燥用流体の液層の厚みを大きくすることができるので、基板1として既にパターンが形成されたものを採用する場合であっても、パターンの内部(凹入部)にまで乾燥用流体の液層を形成することができ、ひいては、パターンの内部をも含めて基板1の全表面をマランゴニ効果によって迅速に、かつむらなく露出部分を乾燥させることができる。この結果、高アスペ10 クト化対応が可能になる。

さらに、乾燥用流体の液滴 1 2 の噴出速度が上述のように設定されているので、 基板 1 どうしの間隔が小さく設定されている場合であっても、処理液 1 1 の液面に 乾燥用流体を確実に供給して液層を形成することができる。もちろん、基板のうち 処理液 1 1 の液面から露出している部分にも乾燥用流体の液層を形成することができる。

さらにまた、上記の一連の処理を室温で行うことが好ましく、この場合には、加 熱用機器が不要であるから、基板処理装置の構成を簡略化することができるととも に、安全性を向上させることができる。

第3図は基板処理装置の他の構成例の要部を示す概略図、第4図は基板処理装置 20 のさらに他の構成例の要部を示す概略図である。

これらの基板処理装置が第1図の基板処理装置と異なる点は、乾燥用流体ノズル、6 dの個数のみである。具体的には、第3図の基板処理装置においては2個の乾燥用流体ノズル6 dを、第4図の基板処理装置においては3個の乾燥用流体ノズル6 dを、それぞれ設けている。

25 したがって、これらの実施能様を採用した場合には、基板1が大径になり、基板 1どうしの間隔が小さくなった場合であっても、基板1の全表面をむらなく乾燥さ

10

15

せることができる。

第5図は基板処理装置のさらに他の構成例を示す概略図である。

この基板処理装置が前記の基板処理装置と異なる点は、不活性ガスタンク7a、不活性ガスタンク7aから窒素などの不活性ガスを導出する不活性ガス供給管路7 b、不活性ガス供給管路7 b の所定位置に設けた開閉弁7cおよびポンプ7d、不活性ガス供給管路7 b を通して供給された不活性ガスを噴出させる不活性ガスノズル7eを含む不活性ガス供給部7をさらに有している点のみである。ただし、不活性ガスノズル7eを乾燥用流体ノズル6dと兼用させることが可能である。また、不活性ガスの流量は0リットル/minよりも多く、かつ20リットル/min以下であればよいが、5リットル/minよりも多く、かつ20リットル/min・以下であればよいが、5リットル/minよりも多く、かつ20リットル/min・以下であることが好ましい。さらに、制御部10によって、不活性ガス供給部7をも制御するようにしている。

したがって、この構成例を採用した場合には、処理槽2内に不活性ガスを供給することにより、処理液排出時において処理槽2の内部が負圧になり、外部から不純物が侵入するという不都合の発生を防止することができる。

また、処理液排出時において、乾燥用流体の液滴12の流量、および/または不活性ガスの流量を増加させることが好ましく、処理液11の液面が低下しても、処理液11の液面まで乾燥用流体の液滴12を確実に供給して乾燥用流体の液層を形成することができる。

20 また、処理液の排出前に処理槽2の内部を不活性ガス雰囲気とすることができ、 この場合には、基板1にウォーターマークが発生することを抑制することができる。 第6図は基板処理装置のさらに他の構成例の要部を示す概略図である。

この基板処理装置が前記の基板処理装置と異なる点は、乾燥用流体ノズル6を昇降させる昇降部8をさらに含む点のみである。ここで、昇降機構8としては、ラックアンドピニオン機構、ピストン機構などの従来公知の往復動機構を採用することができる。そして、昇降距離は、0mmよりも大きく、かつ500mm以下であれ

ばよいが、250mm以上、かつ350mm以下であることが好ましい。また、制御部10によって、昇降機構8をも制御するようにしている。

したがって、この構成例を採用した場合には、処理液排出時において、乾燥用流体ノズル6 dを下降させることにより、処理液11の液面が低下しても、処理液11の液面まで乾燥用流体の液滴12を確実に供給して乾燥用流体の液層を形成することができる(第7図参照)。

第8図は基板処理装置のさらに他の構成例の要部を示す概略図である。

この基板処理装置は、処理槽2と、処理槽2を包囲する密閉可能な外槽13と、基板(例えば、半導体ウエハ)1を立設状態で支持するとともに、処理槽2に対して基板を搬入、搬出する第1支持部材14と、処理槽2の内部において昇降可能であるとともに、第1支持部材14との間で基板1の受け渡しを行う第2支持部材15とを有している。なお、2aは処理槽2から洗浄液(例えば、純水)を排出するための洗浄液排出管である。

上記の構成の基板処理装置の作用は次のとおりである。

基板の洗浄が終了した時点においては、第8図に示すように、処理槽2に洗浄液(例えば、純水)が充満しているとともに、基板1が第1支持部材14に自然な状態で支持され、かつ洗浄液に浸漬されている。なお、この状態においては、基板1は第2支持部材15から離れている。そして、洗浄された基板1を乾燥するために、密閉された外槽13の蓋体を通して乾燥用流体(例えば、イソプロピルアルコール20 蒸気、ミストなど)を外槽13内に供給するとともに、洗浄液排出管2aを通して洗浄液を処理槽2から排出する。

この動作を行えば、基板1のうち、洗浄液から露出した部分において、洗浄液を 乾燥用流体膜で置換することにより、迅速な乾燥を達成する。

洗浄液の排出を継続することにより、洗浄液の液面が徐々に下降し、第9図に示 25 すように、液面が第2支持部材15と第1支持部材14との間に位置すれば、第2 支持部材15が乾燥するとともに、第2支持部材15に支持されることになる基板

1の部分も乾燥する。

そして、第2支持部材15を上昇させて基板1と係合させ(第10図参照)、次いで、第1支持部材14を下降させることにより、基板1を第1支持部材14から第2支持部材15に受け渡すことができる(第11図参照)。このようにして基板1の受け渡しを行う間において、基板1と処理槽2との相対位置が一定に保持されているので、基板1と洗浄液の液面との相対速度が一定に保持され、ばらつきのない乾燥を達成することができる。

その後も、乾燥用流体の供給および洗浄液の排出が行われるのであるから、基板 1の残りの部分の全表面および第1支持部材14が乾燥される。

- 10 洗浄液の排出が完了した後は、外槽13の蓋体を通して窒素ガスを供給することにより、第1支持部材14、第2支持部材15と基板1との接している部分に洗浄液の残留がないため、処理槽2および外槽13の内部から乾燥用流体を排出して、基板1の乾燥処理を完了する。したがって、窒素ガスの使用量を少なくすることができる。また、全体としての所要時間を短縮することができる。
- 15 以上のようにして乾燥処理が完了した場合には、外槽13を開蓋し、第1支持部 材14を上昇させることにより、乾燥した基板1の取り出しを行うことができる。 このように、基板を持ち替えるようにした場合には、4~5分で基板の乾燥を完 了することができる。

具体的には、基板として半導体ウエハーを用い、乾燥用流体としてIPAを用い、 20 乾燥用流体の流量を4cc/minに設定し、処理液として純水を用い、不活性ガスとして窒素を用い、不活性ガスの流量を20リットル/minに設定し、乾燥用流体ノズル6dとしてPEEKからなるものを採用し、乾燥用流体ノズル6dの個数を2に設定し、乾燥用流体ノズル6dに形成される乾燥用流体噴出孔の口径を0.2mmに設定し、乾燥用流体噴出孔の長さ(乾燥用流体ノズル6dの肉厚)を1m 25 mに設定し、乾燥用流体噴出孔の数を51に設定し(50枚の基板1に対応させ)、乾燥用流体ノズル6dの垂直位置を基板の上面から100mm上方に、かつ水平位

10

15

置を基板1の中心から各々75 mmに設定し、処理液の排出速度を2mm/secに設定し、しかも基板を持ち替えるようにして半導体ウエハーの乾燥を行わせたところ、乾燥所要時間は4分であった。なお、この具体例における液滴の粒径は190 μ m前後であり、乾燥用流体の液層厚みは浸漬界面全体の平均で50 μ m (ノズルの直下は厚く、基板の端付近は薄い)であり、噴出速度は208 m/sであった。第12 図は基板処理装置のさらに他の構成例の要部を示す概略図である。

この基板処理装置が前記の基板処理装置と異なる点は、基板 1 を垂直に支承する代わりに、垂直面に対して所定角度だけ傾斜させた状態で基板 1 を支承する点、および基板 1 の傾斜に合わせて乾燥用流体の液滴 1 2 を噴出できるように乾燥用流体ノズル 6 d を傾斜させた点のみである。ここで、傾斜角度は、0° よりも大きく、かつ 3 0° 以下であればよいが、 $3\sim5$ ° に設定することが好ましい。

したがって、この構成例を採用した場合には、一方の表面に既にパターンが形成された基板1の乾燥を迅速に、かつむらなく達成することができる。また、傾斜角度を上記のように設定しているので、パターンの内部の洗浄液が排出されにくいという不都合の発生、乾燥用流体を浸漬界面に供給するのが困難になるという不都合の発生、パターンから排出された洗浄液が隣の基板に滴下するという不都合の発生を防止することができる。

さらに説明する。

基板1の一方の表面にパターンが形成されている場合には、パターン形成面がや や下向きになるように基板1を傾斜させればよく、この場合には、第13図に示すように、パターンの形成に伴って形成された凹入部1aがやや下向きになるので、徐々に下降する処理液11の液面よりも上方に位置する凹入部1aからの処理液11の排出がスムーズに行われる。この結果、凹入部1aに残留する処理液11の量を大幅に低減して、乾燥用流体の液層が形成されることに伴う基板表面の乾燥を一 25 層良好に達成することができる。

第14図は、基板処理装置のさらに他の構成例を示す概略図である。

この基板処理装置が前記の基板処理装置と異なる点は、乾燥用流体供給部6の構成のみである。

この構成例における乾燥用流体供給部6は、1対の乾燥用流体タンク6a1、6 a2と、各乾燥用流体タンク6a1、6a2と乾燥用流体ノズル6dとを連通する 第1、第2連通管路6 b 1、6 b 2 と、各連通管路6 b 1、6 b 2の所定位置に設 5 けた開閉弁6 c 1 、6 c 2 と、両連通管路6 b 1 、6 b 2 の開閉弁6 c 1 、6 c 2 よりも上流側の所定位置どうしを連通する第1循環管路6kと、第1循環管路6k の所定位置に設けた開閉弁6 f と、両乾燥用流体タンク6 a 1、6 a 2 どうしを連 通する第2循環管路6gと、第2循環管路6gの所定位置に設けた開閉弁6hとを 有している。なお、6 i は、乾燥用流体ノズル6 d に不活性ガスを供給する不活性 ガス供給管路、6 j 1、6 j 2は各乾燥用流体タンク6 a 1、6 a 2に設けられた 逃がし弁、6m1、6m2は各乾燥用流体タンク6a1、6a2に不活性ガスを供 給する不活性ガス供給管路、6n1、6n2は各不活性ガス供給管路6m1、6m 2の所定位置に設けた開閉弁である。また、開閉弁6 c 2 、6 f は流量調整機能を 有するものである。そして、乾燥用流体タンク6a1を本タンクに設定し、乾燥用 15 流体タンク6a2を予備タンクに設定している。

したがって、この構成例を採用した場合には、以下のようにして乾燥用流体の液 滴12を噴出させる状態と乾燥用流体を循環させる状態とを選択することができる。

(1) 乾燥用流体の液滴12噴出動作を行う場合

20 この動作を行わせる場合には、制御部によって開閉弁6n1、6c1、6c2、6j2を開くとともに、開閉弁6f、6n2、6h、6j1を閉じる。

この状態においては、不活性ガス供給管路6m1を通して乾燥用流体タンク6a 1に不活性ガスを供給することができ、第1連通管路6b1を通して乾燥用流体ノ ズル6dに乾燥用流体を圧送することができる。そして、乾燥用流体ノズル6dに は不活性ガス供給管路6iを通して不活性ガスが供給されているので、乾燥用流体 ノズル6dから乾燥用流体と不活性ガスが共に噴出され、ひいては、乾燥用流体を 液滴12として噴出させることができる(第14図中実線矢印参照)。

(2) 乾燥用流体の液滴12噴出動作を行わない場合

この場合には、制御部によって開閉弁 6 f、6 j 1、6 j 2を開くとともに、開閉弁 6 c 1、6 c 2、6 h、6 n 1、6 n 2を閉じる。

- 5 この状態においては、両乾燥用流体タンク6a1、6a2と乾燥用流体ノズル6 dとの連通を遮断するとともに、両乾燥用流体タンク6a1、6a2どうしの連通を確保するので、乾燥用流体タンク6a1の内部が高圧である場合に、乾燥用流体タンク6a1の内部の乾燥用流体を乾燥用流体タンク6a2に移動させることができる(図14中破線矢印参照)。したがって、この状態においては乾燥用流体が消費されず、乾燥用流体の消費量を削減して、ランニングコストを低減することができる。
 - (3) 乾燥用流体タンク6 a 2から乾燥用流体タンク6 a 1へ乾燥用流体を移動 させる場合

この場合には、制御部によって開閉弁6h、6j1、6n2を開くとともに、開 15 閉弁6c1、6c2、6f、6j2、6n1を閉じる。

この状態においては、両乾燥用流体タンク6a1、6a2どうしが第2循環管路6gのみを介して連通されるとともに、乾燥用流体タンク6a2のみに不活性ガスが供給されるので、乾燥用流体タンク6a2の内部の乾燥用流体を乾燥用流体タンク6a1へ移動させることができる。

- 20 また、乾燥用流体を循環させている間は、不活性ガスが第2連通管路6b2を通して乾燥用流体タンク6aに供給され、循環流路内の圧力を外部圧力よりも高くすることができるので、外部から不純物が侵入することを防止することができる(第11図中の破線矢印参照)。
- 25 産業上の利用可能性

この発明は、半導体ウエハーなどの基板の表面を乾燥させる用途に適用可能であり、迅速、かつむらのない乾燥を達成することができる。

5

10

15

20

25

請求の範囲

1. 処理槽内に基板を収容し、かつ処理槽内における洗浄液の液面を基板に対して相対的に下降させながら処理槽内に乾燥用流体を供給することにより基板の表面を乾燥させるに当たって、

乾燥用流体を液の状態で処理槽内に導入し、ノズルを用いて乾燥用流体の液滴を 形成して洗浄液面上に供給することを特徴とする基板乾燥方法。

- 2. 処理槽内において基板を所定角度だけ傾斜させた状態で収容し、ノズルを 用いて傾斜された基板の向きと同じ方向に乾燥用流体の液滴を供給する請求項1に 10 記載の基板乾燥方法。
 - 3. 洗浄液の液面における基板の全幅にわたって乾燥用流体が広がるように、乾燥用流体の処理槽内への導入に方向性を持たせるとともに、乾燥用流体の導入初速を設定する請求項1または請求項2に記載の基板乾燥方法。
- 4. 洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽に不活性ガスを供給する請求 15 項1から請求項3の何れかに記載の基板乾燥方法。
 - 5. 洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽への乾燥用流体および/または不活性ガスの供給量を増加させる請求項4に記載の基板乾燥方法。
 - 6. 洗浄液の処理槽からの排出に伴って、基板の支承位置を変化させる請求項 1から請求項4の何れかに記載の基板乾燥方法。
- 20 7. 洗浄液の排出前に処理槽内を不活性ガス雰囲気に設定する請求項4または 請求項5に記載の基板乾燥方法。
 - 8. 洗浄工程およびその後の乾燥工程を室温で行う請求項1から請求項7の何 れかに記載の基板乾燥方法。
- 9. ノズルに供給される不活性ガスにより乾燥用流体を圧送する請求項1から 25 請求項8の何れかに記載の基板乾燥方法。
 - 10. 処理槽内において支承手段によって基板を支承し、かつ処理槽内におけ

15

る洗浄液の液面を基板に対して相対的に下降させながら処理槽内に乾燥用流体を供給することにより基板の表面を乾燥させる基板乾燥装置において、

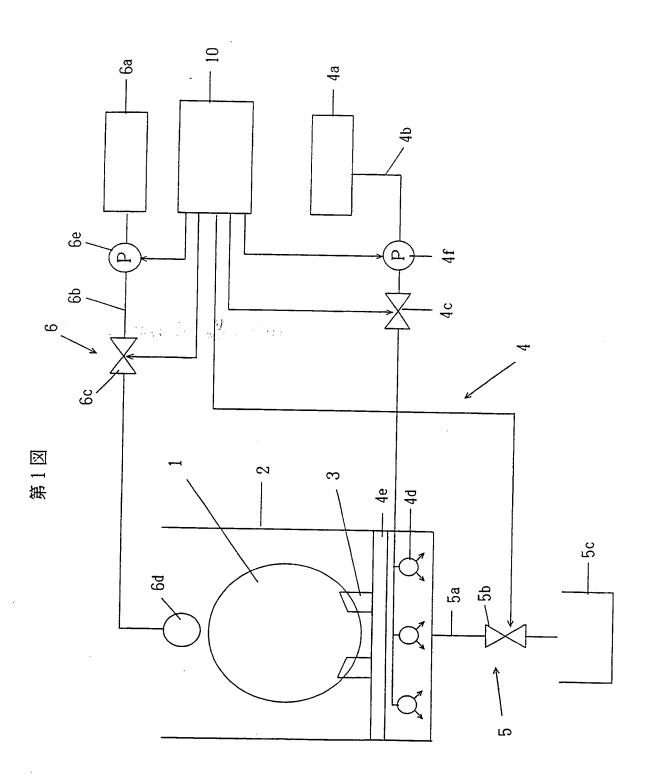
乾燥用流体を液の状態で処理槽内に導入し、ノズルを用いて乾燥用流体の液滴を 形成して洗浄液面上に供給する乾燥用流体供給手段を含むことを特徴とする基板乾燥装置。

- 11. 前記支承手段は、処理槽内において基板を所定角度だけ傾斜させた状態で支承するものであり、前記ノズルは、傾斜された基板の向きと同じ方向に乾燥用流体の液滴を供給するものである請求項10に記載の基板乾燥装置。
- 12. 前記乾燥用流体供給手段は、洗浄液の液面における基板の全幅にわたっ で乾燥用流体が広がるように、乾燥用流体の処理槽内への導入に方向性を持たせる とともに、乾燥用流体の導入初速を設定するものである請求項10または請求項1 1に記載の基板乾燥装置。
 - 13. 洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽に不活性ガスを供給する不活性ガス供給手段をさらに含む請求項10から請求項12の何れかに記載の基板乾燥装置。
 - 14. 洗浄液の処理槽からの排出に伴って、処理槽への乾燥用流体および/または不活性ガスの供給量を増加させる供給量制御手段をさらに含む請求項13に記載の基板乾燥装置。
- 15. 前記支承手段は、基板支承箇所に対して下向きに連続して洗浄液導入用 20 溝を有するものである請求項10から請求項14の何れかに記載の基板乾燥装置。
 - 16. 前記支承手段は、基板の互いに異なる位置を選択的に支承する1対の支承手段であり、洗浄液の処理槽からの排出に伴って、支承手段による基板の支承位置を変化させる支承位置制御手段をさらに含む請求項10から請求項15に記載の基板乾燥装置。
- 25 17. 洗浄液の排出前に処理槽内を不活性ガス雰囲気に設定する雰囲気設定手 段をさらに含む請求項13または請求項14に記載の基板乾燥装置。

- 18. 洗浄液の処理槽からの排出に伴って、ノズルを基板に接近させるノズル位置制御手段をさらに含む請求項10から請求項13、請求項15から請求項17の何れかに記載の基板乾燥装置。
- 19. 非噴出時に乾燥用流体を循環させる循環手段をさらに含む請求項10か 5 ら請求項18の何れかに記載の基板乾燥装置。
 - 20. ノズルの設置個数は基板サイズ、基板ピッチに応じて設定されている請求項10から請求項19の何れかに記載の基板乾燥装置。
- 21. ノズルは、同時に乾燥されるべき基板の枚数よりも1つだけ多い数の乾燥用流体噴出孔を有している請求項10から請求項20の何れかに記載の基板乾燥 10 装置。
 - 22. 乾燥用流体を圧送すべくノズルに不活性ガスを供給する不活性ガス供給 手段をさらに含む請求項10から請求項21の何れかに記載の基板乾燥装置。

20

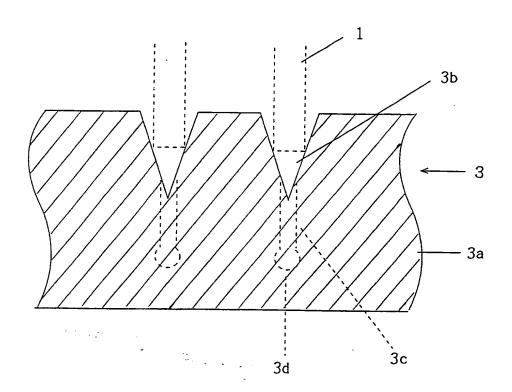
THIS PAGE BLANK (USPTO)



THIS PAGE BLANK (USPTO)

2/11

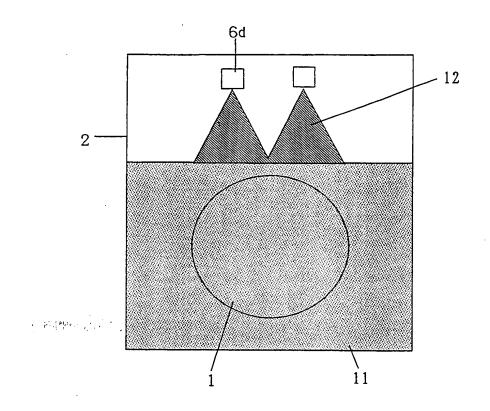
第2図



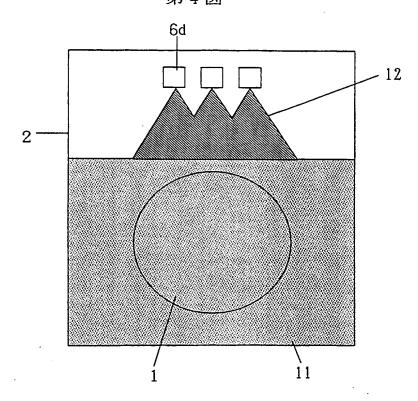
THIS PAGE BLANK (USPTO)

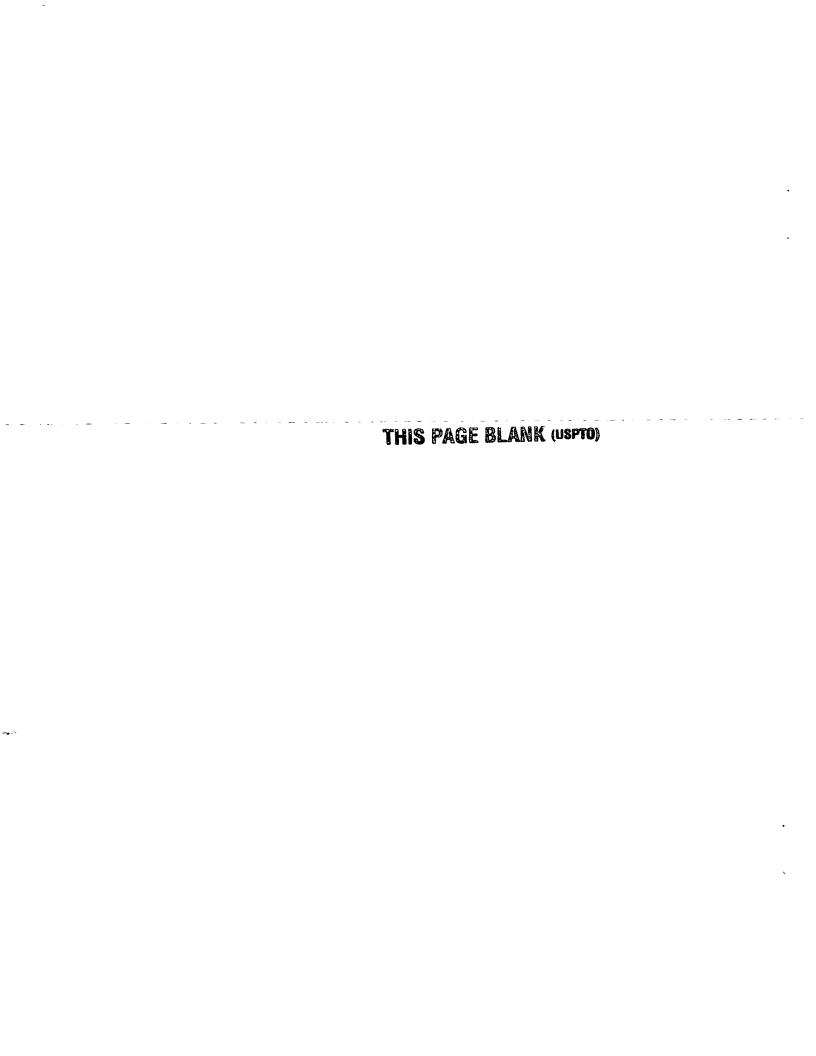
3/11

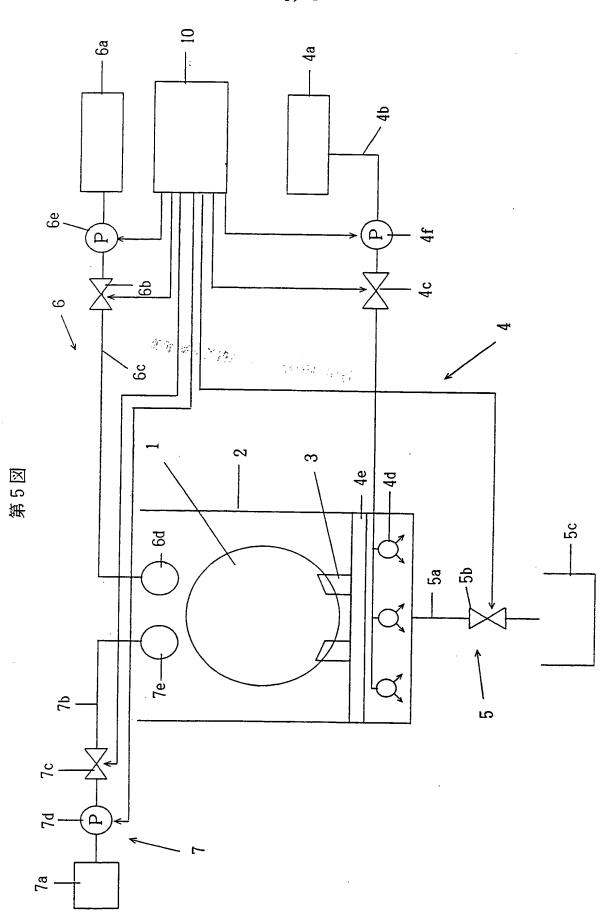
第3図



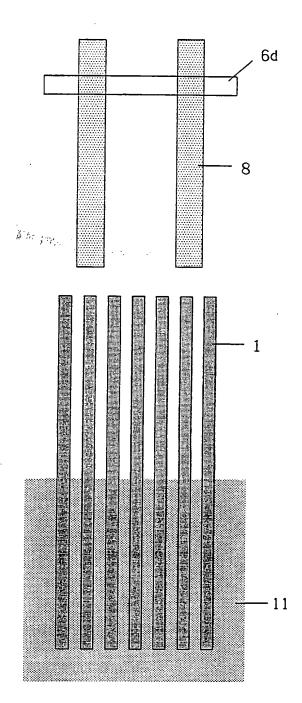
第4図





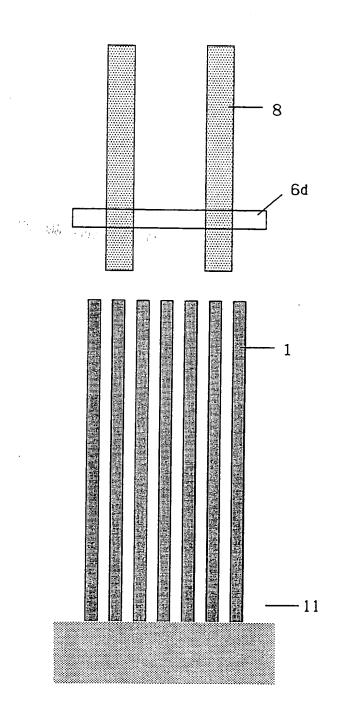


第6図



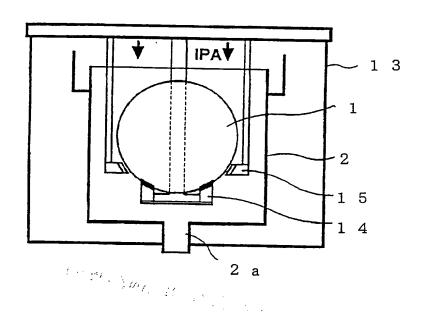
6/11

第7図

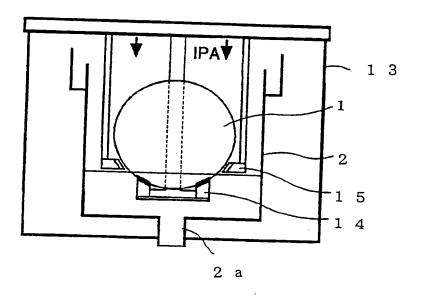


7/11

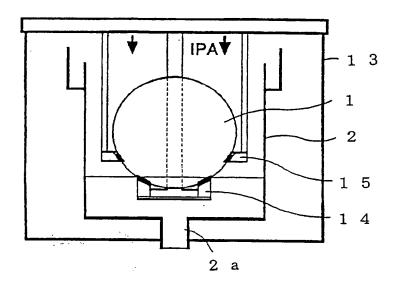
第 8 図



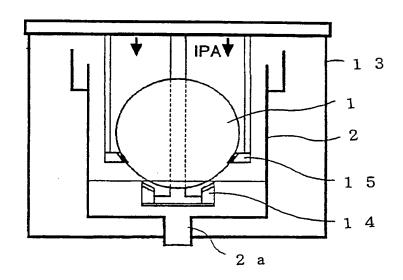
第 9 図



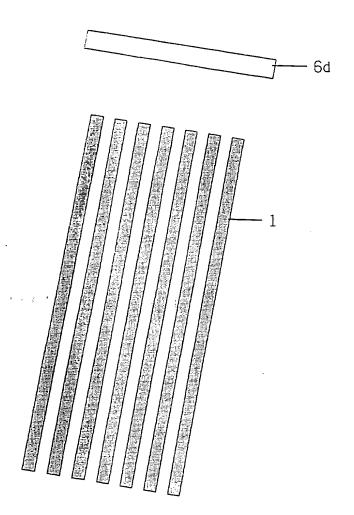
第 1 0 図



第 1 1 図



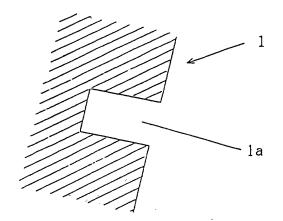
9/11 第 1 2 図



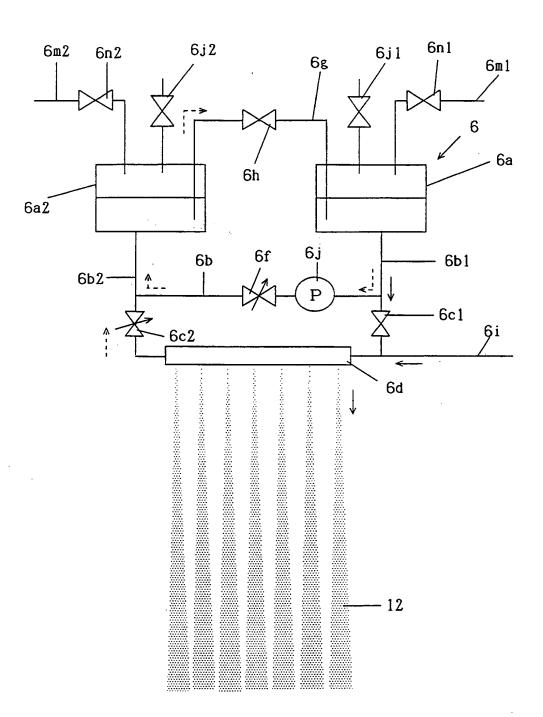
WO 01/53766 PCT/JP00/00175

10/11

第 1 3 図



第14図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/00175

			101/0100/001/3			
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER .Cl ⁷ F26B 21/04, H01L 21/304					
1110.						
A coording t	a International Patent Classification (IPC) or to both n	etianal alassification and IDC				
	o International Patent Classification (IPC) or to both na S SEARCHED	itional classification and if	****			
Minimum de	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)				
Int.	.Cl ⁷ F26B 21/00-21/04, H01L 21/	/304				
į						
	tion searched other than minimum documentation to the					
	suyo Shinan Koho 1971-1996 ni Jitsuyo Shinan Koho 1971-1996		hinan Koho 1994-2000 oroku Koho 1996-2000			
	<u> </u>	-				
Electronic d	lata base consulted during the international search (name	e of data base and, where pract	icable, search terms used)			
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passa	nges Relevant to claim No.			
Х	JP, 11-176796, A (Sony Corporat		1,3,4,7-10,12,			
Y	02 July, 1999 (02.07.99) (Fam	ily: none)	13,17,20,22 6,16			
A			2,5,6,11,14,			
l !			15,18,19,21			
Y	JP, 11-345798, A (Daikin Indust		6,16			
	14 December, 1999 (14.12.99)	(Family: none)				
A	JP, 10-335299, A (Sony Corporat		1-22			
	18 December, 1998 (18.12.98)	(Family: none)				
A	JP, 2000-12505, A (Dainippon So	creen MFG. Co., Ltd	d.), 1-22			
	14 January, 2000 (14.01.00) (Family: none)				
	I					
Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex	<u></u>			
	categories of cited documents:		after the international filing date or			
consider	ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance	priority date and not in con	reflict with the application but cited to			
	document but published on or after the international filing	"X" document of particular rele	evance; the claimed invention cannot be t be considered to involve an inventive			
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	step when the document is	taken alone			
special i	reason (as specified)	considered to involve an in	evance; the claimed invention cannot be eventive step when the document is			
means	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combination being obvious	e other such documents, such s to a person skilled in the art			
	ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed	"&" document member of the sa	ame patent family			
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the						
U6 A	06 April, 2000 (06.04.00) 18 April, 2000 (18.04.00)					
Name and m	ailing address of the ISA/	Authorized officer				
	nese Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/00175

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl 7 F26B 21/04, H01L 21/304

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' F26B 21/00-21/04, H01L 21/304

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1971年-1996年

日本国公開実用新案公報 1971年-1996年

日本国登録実用新案公報 1994年-2000年

日本国実用新案登録公報 1996年-2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

С.	関連する	らと認っ	められ	る文献

0. 124		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP, 11-176796, A (ソニー株式会社), 2.7.1999 (02.07.99) (ファミリーなし)	1, 3, 4, 7–10, 12, 13, 17, 20, 22
Y		6, 16
A		2, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 21

$|\mathbf{X}|$ C欄の続きにも文献が列挙されている。

| | パテントファミリーに関する別紙を参照。

- 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

06.04.00

国際調査報告の発送日、3.04.0()

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

新海 岳

3 L 印

8111

電話番号 03-3581-1101 内線 3335



国際出願番号 PCT/JP00/00175

C (続き) .	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 11-345798, A (ダイキン工業株式会社), 14. 12月. 1999 (14. 12. 99) (ファミリーなし)	6, 16
A	JP, 10-335299, A(ソニー株式会社), 18. 12月. 1998(18. 12. 98)(ファミリーなし)	1-22
A	JP, 2000-12505, A (大日本スクリーン製造株式会社), 14.1月.2000 (14.01.00) (ファミリーなし)	1-22
	i	

PCT

ΕP



国際調査報告

(在8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 PCTSD99 の書類記号 -1178	今後の手続きについては		の送付通知様式(PCT/ISA/22 参照すること。	0)
の音類記ち「1178」	. 11 12 41 - 47 12 1	及い下記さを	Ømy o⊂c.	
国際出願番号 PCT/JP00/00175	国際出願日 (日.月.年) 17.01		優先日 (日. 月. 年)	
出願人 (氏名又は名称) 東邦化成株式会	≙ ≵+			
米が同点がある。	7. T.			
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される		(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。	٠.
この国際調査報告は、全部で 3	ページである。			•
□ この調査報告に引用された先行技	術文献の写しも添付され	ている。		
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出され				
b. この国際出願は、ヌクレオチド この国際出願に含まれる書		でおり、次の配	列表に基づき国際調査を行った。	
この国際出願と共に提出され	れたフレキシブルディスク	による配列表		
□ 出願後に、この国際調査機関	関に提出された書面による	配列表		
出願後に、この国際調査機関	関に提出されたフレキシフ	゚ ルディスクに ゚	よる配列表	
□ 出願後に提出した書面による 書の提出があった。	る配列表が出願時における	国際出願の開え	Fの範囲を超える事項を含まない旨の陳 	述
■ 書面による配列表に記載した 書の提出があった。	た配列とフレキシブルディ	スクによる配列	列表に記録した配列が同一である旨の 陳	(述
2. 請求の範囲の一部の調査が	『できない(第 I 欄参照)。	,		
3. 第明の単一性が欠如してい	ゝる(第Ⅱ欄参照)。			
4. 発明の名称は 🗓 出願	負人が提出したものを承認	する。		
□ 次に	ニ示すように国際調査機関	が作成した。		
_				
5. 要約は 🗓 出願	負人が提出したものを承認	する。		
国際		願人は、この国	47条(PCT規則38.2(b))の規定によ 際調査報告の発送の日から1カ月以内に る。	
6. 要約書とともに公表される図は、 第 1 図とする。図 出願	種人が示したとおりである	•	□ なし	٠

□ 出願人は図を示さなかった。

本図は発明の特徴を一層よく表している。

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' F26B 21/04, H01L 21/304

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' F26B 21/00-21/04, H01L 21/304

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1971年-1996年

日本国公開実用新案公報 1971年-1996年

日本国登録実用新案公報 1994年-2000年

日本国実用新案登録公報 1996年-2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連す	ると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
x V	JP, 11-176796, A (ソニー株式会社), 2.7.1999(02.07.99) (ファミリーなし)	1, 3, 4, 7-10, 12, 13, 17, 20, 22
Y	·	6, 16
A		2, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 21

|X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

06.04.00

国際調査報告の発送日、2.04.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

新海 岳 3 L 8111

電話番号 03-3581-1101 内線 3335

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	国际 树 互സ口		
C (続き). 引用文献の カテゴリー*	関連すると認められる文献 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときら	ナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 11-345798, A (ダイキ 14. 12月. 1999 (14. 12. 9		6, 16
A	JP, 10-335299, A (ソニー 18. 12月. 1998 (18. 12. 9		1-22
A	JP, 2000-12505, A (大日社), 14. 1月. 2000 (14. 01	本スクリーン製造株式会 . 00) (ファミリーなし)	1-22
		-	
			·
		·	
	·	·	
			·

PATENT COOPERATION TREATY

To:

From	the	INT	ERN.	ATIC	DNAL	BUREA	۱U
------	-----	-----	------	------	------	-------	----

PCT

NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

TSUGAWA, Tomoo Lions Mansion Noe No. 1201 7-7, Chuo 2-chome Joto-ku, Osaka-shi Osaka 536-0005 JAPON

Date of mailing (day/month/year)	:
00 F-h 0000 (00 00 00)	IMPORTANT NOTIFICATION
02 February 2000 (02.02.00)	
Applicant's or agent's file reference	International application No.
PCTSD99-1178	
FC13D33-1170	PCT/JP00/00175

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

TOHO KASEI CO., LTD. et al (for all designated States except US)

MAEDA, Norio et al (for US)

International filing date

17 January 2000 (17.01.00)

Priority date(s) claimed

Date of receipt of the record copy

by the International Bureau

28 January 2000 (28.01.00)

List of designated Offices

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE National:JP,KR,US

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

X time limits for entry into the national phase

confirmation of precautionary designations

requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Susumu Kubo

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/301 (July 1998)

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

003082198

ANNEX TO FORM PCT/IB/301

INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by the applicable national laws.

The time limit for performing these procedural acts is 20 MONTHS from the priority date or, for those designated States which the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, 30 MONTHS from the priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or elected) Offices have fixed time limits which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available.

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant Chapters of Volume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in Chapter IX of Volume I of the PCT Applicant's Guide.

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may, therefore, be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 8 September 1997, respectively, regardless of the filing date of the international application. (See second paragraph above.)

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these designations are correct. Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c) before the expiration of 15 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.

REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the International application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the international Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit is the filling date of the earliest application whose priority is claimed.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

TSUGAWA, Tomoo
Lions Mansion Noe No. 1201
7-7, Chuo 2-chome
Joto-ku, Osaka-shi
Osaka 536-0005
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 26 July 2001 (26.07.01)

Applicant's or agent's file reference

PCTSD99-1178

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP00/00175

International filing date (day/month/year)
17 January 2000 (17.01.00)

Priority date (day/month/year)

Applicant

TOHO KASEI CO., LTD. et al

 Notice is hereby given that the international Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time: EP,JP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the international Bureau on 26 July 2001 (26.07.01) under No. WO 01/53766

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent international Preliminary Examining Authority before the expiration of 18 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or regident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

if the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

1001101101101 (41-22) 038.83.36

Form PCT/IB/308 (July 1996)

4160661

PCT	For receiving Office use only		
101			
DEOLIESA	International Application No.		
REQUEST	International Filing Date		
The undersigned requests that the present			
international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office and "PCT International Application"		
Tody.	Applicant's or agent's file reference		
Box No. I TITLE OF INVENTION	(if desired) (12 characters maximum) PCTSD99-1178		
Method and Device for Drying S	Substrate		
Box No. II APPLICANT			
Name and address: (family name followed by given name; for designation. The address must include postal code and name of a address indicated in this Box is the applicant's State (that is, coun of residence is indicated below.)	a legal entity, full official ountry. The country of the try) of residence if no State This person is also inventor.		
TOHO KASEI, LTD	Telephone No. 0743-59-2350		
6-2, Imakokubu-cho, Yamatokouriyama-shi,	Facsimile No. 0743-59-2361		
Nara 639-1031 Japan	Teleprinter No.		
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residence: JAPAN		
This person is applicant for the purposes of: all designated all designated the United	ated States except States of America I States of America I States of America only The States indicated in the Supplemental Box		
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FUR	The state of the s		
Name and address: (Family name followed by given name: for designation. The address must include postal code and name of caddress indicated in this Bax is the applicant's State (that is, count of residence is indicated below.)	a legal entity, full official puntry. The country of the try) of residence if no State This person is:		
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	applicant only		
	applicant and inventor		
Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi	2-chome, inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)		
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8323 Japan State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:		
JAPAN	JAPAN		
	ted States except States of America the United States the States indicated in the Supplemental Box		
Further applicants and/or (further) inventors are indicated			
	E; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE		
The person identified below is hereby/has been appointed to act of the applicant(s) before the competent International Authorities	is as:		
Name and address: (Family name followed by given name; for designation. The address must include postal	a legal entity, full official code and name of country.) O6-6935-6250		
(8780) TSUGAWA Tomoo	Facsimile No.		
Lions Mansion Noe No.1201, 7-7, Chuo 2-chom	06-6935-6244		
Joto-ku, Osaka-shi, Osaka 536-0005 Japan			
Address for correspondence: Mark this check-box where space above is used instead to indicate a special address to	no agent or common representative is/has been appointed and the		
Form Ig dO/ICE 198 'ONet) (July 1998: reprint January 2001)	which correspondence should be sell.		

		2
Chan	NIA	

Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/UK (FURTHER) INVENTOR(S)				
If none of the following sub-baxes is used, this sheet should not be in	ocluded in the request.			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State This person is:				
MAEDA Norio	applicant only			
C/O TOLIO MACRIANDO CO Y	applicant and inventor			
C/O TOHO KASEI, LTD., 6 2, Imakokubu-cho, Yamutokouriyama-shi. Nara 639-1031 Japan	Inventor only (If this check-box is marked, do not fill in helow)			
State (that is, country) of nationality. JAPAN State (that is, country) of	residence: JAPAN			
This person is applicant all designated all designated States except for the purposes of: all designated the United States of America of Office of Control of Cont	United States the States indicated in America only the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include nostal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)	This person is:			
SUMI Koji	applicant only			
<u>.</u>	applicant and inventor			
C/O TOHO KASEI, LTD., 6-2, Imakokubu-cho,	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)			
Yamatokouriyama-shi, Nara 639 1031 Japan				
State (that is, country) of nationality: JAPAN State (that is, country) of	residence: JAFAN			
This person is applicant all designated all designated States except for the purposes of: all designated the United States of America of America	United States The States indicated in the Eupplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postul code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)	This person is:			
C/O Kanaoka koujou, Sakai Seisakusho of Daikin	applicant and inventor			
Industries, Ltd., 1304. Kanaoka-cho, Sakai-shi,	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)			
Osaka 591-8022 Japan State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of				
JAPAN	residence: JAPAN			
the United States of America V of	United States are the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name: for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)	This person is:			
OONO Mesau	applicant only			
C/O Kanaoka koujou, Sakai Seisakusho of Daikin	applicant and inventor			
Industries, Ltd., 1304, Kanauka-cho, Sakai-shi, is marked, do not fill in below.)				
Osaka 591-8022 Japan				
State (that is, country) of pationality: JAPAN State (that is, country) of r	residence: JAPAN			
This person is applicant all designated all designated States except the United States of America only the States Indicated in the United States of America only the Supplemental Box				
Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation cheet. POT/RO/101 (continuation sheet) (July 1998, reuring January 2001) See Manual 1				

See Notes to the request form

瓶拂網

Sheet No	3	
Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S)		I) INVENTOR(S)
If none of the following sub-boxes is used, th		
Name and address: (Family name followed by given name: for a designation. The address must include postal code and name of counaddress indicated in this Box is the applicant's State (that is, country of residence is indicated below.)	legal entity, full officia	1
MATSUMOTO Takao		applicant only
C/O Kanaoka koujou, Sakai Seisakusho of Daikin	1	2pplicant and inventor
Industries, Ltd., 1304, Kanaoka cho, Sakai shi,		inventor only (If this clieck-box is marked, do not fill in below.)
Osaka 591-8022 Japan State (that is, country) of nationality:	1.0	
JAPAN	State (that is, country	JAPAN
This person is applicant all designated for the purposes of: all designated the United States all designated the United States all designated the United States all designated all des	States except ates of America	the United States of America only the States indicated in the Supplemental Box
Name and address: (Family name followed by given name; for a lassignation. The address must include postal code and name of couraddress indicated in this Box is the applicant's State (that is, country, of residence is indicated below.) IZUTANI Naoaki	egal enity, full officia ntry. The country of the of residence if no State	7
C/O Kanaoka koujou, Sakai Seisakusho of Daikir	ı	applicant and inventor
Industries, Ltd., 1304, Kanaoka-cho, Sakai-shi,		inventor only (If this check-box
Osaka 591-8022 Japan		is marked, do not fill in below.)
State (that is, country) of nationality. JAPAN	State (that is, country) of residence: JAPAN
This person is applicant all designated all designated for the purposes of:	States except	the United States of America only the States indicated in the Supplemental Box
Name and address: (Family name followed by given name: for a la designation. The address must include postal code and name of coun address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)	egal ontiry, full officia iny. The country of the of residence if no State	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check box is marked, do not fill in below.)
State (thai Is, country) of nationality:	State (that is, countr)	y of residence;
	ites of America	the United States of America only the States Indicated in the Supplemental Box
Name and address: (Family name followed by given name; for a ladsignation. The address must include postal code and name of counaddress indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)	egal eniity, full officia itry. The country of the of residence if no Statu	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-bar is marked, do not fill in below.)
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country,) of residence.
This person is applicant all designated for the purposes of: all designated Sures the United Sta	States except ates of America	the United States indicated in the States indicated in the Supplemental Box
Further applicants and/or (further) inventors are indicated or	n another continuation	n sheet.
orm PC1/RO/101 (continuation sheet) (July 1998; reprint January)	2001)	See Notes to the request for

See Notes to the request form

_	Box N		_						
The following designations are hereby made under Rule 4.9(2) (mark the applicable check-boxes: at least one must be marked):									
Regional Patent									
1	4A 🗆	ARIPO Patent: GH Ghana C'M Clambia Marka	٠,	iha	MW Malawi, MZ Mozambique, SD Sudan, SL Sierra Leone,				
ł		of the Harare Protocol and of the PCT		-	omnocome, and any other state which is a Contracting State				
1		Eurasian Patent: AM Atmenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, K7. Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent							
	M EP	European Patent: AT Austria, BE Belgium, CII and LI Switzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DF. Germany, DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Nelherlands, PT Portugal, NE Swedom, TR Tendrom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg,							
	I OA	OAPI Patent: RF Burking Faco, BJ Benin, CF Cennal African Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, CA Gabon, CN Guines CW Guines Direct, MI Addition Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon,							
	other State which is a meniber State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if other kind of protection or treatment desired Antional Patent (if other kind of protection or any support of the PCT).								
١	noliek	al Patent (if other kind of protoction or neutment desired, spec							
[] AE	United Arab Emirates			4				
		Antigua and Barbuda		LC					
	آلم [Alhania	-	_	Sri Lauka				
Ī	٦ AM	Armenia,		I.R					
17	AT	Austria		LS	Lesotho				
li] AII	Australia		LT	Lithuania				
Ι'n	7 42	Azerbaijan		LU	Luxembourg				
١ř	7 72 7 R	Possio and Maranasia			Latvia				
٦,	BR	Bosnia and Herzegovina		MA	Morocco				
1 -			<u>ا</u> ــا	עמון	Republic of Moldova				
-	מם נ. מם ר	Bulgaria		MG	Madagasum				
	J PK	Brazil	1	MK	The former Yugoslav Republic of Maccilonia				
	יים נ המר	Belarus		MN	Mongolia				
	J B2	The state of the s		MW	Malawi				
		Cenada		MX	Mexico				
-	1 CH	and LI Switzerland and Liechtensrein		MZ	Muzambique				
-	J CN	China		NO	Norway				
-	J CK	Costa Rica			New Zealand				
-	J CO	CHOR		PL	Poland				
Ļ	JCZ	Czech Republic		PΓ	Portugal				
닏	JDE	Germany		RO	Romania				
닏] DK	Denmark		RII	Russian Federation				
		Dominica		SD	Sudan				
	J DZ	Algeria	_	SE	Sweden				
		Estonia	ī	SG	Singapore				
] E.S	Spain	=	SI	Slovenia				
[-	Finland	_	SK	Slovakia				
C] GB	United Kingdom		SL	Vietra I cone				
	GD	Grenada	$\bar{\Box}$	TJ					
	CE	Georgia	m	TM	Tajikistan				
Ľ.	I CH	Ghana	ö	TR	Turkmenistan				
Ľ] GM	Gambia	ö		Turkey				
	AH [Croatia	_	TZ	Trinidad and Tobago				
	J HU	Hungary	H	UA	United Republic of Tanzania				
] ID	Indonesia		UG	Ukraine				
] IL	Israel		US	Uganda				
	או [India	$\overline{}$	UZ	United States of America				
	115	Iceland	H	VN	Uzbekistan				
V	q1. [_	YU	Vier Nam				
_		v.e		ZA	Yugoslavia				
_	KG	Kyrgyzstan			South Africa				
Ē	KP			ZW	Zimbabwe				
_	KR	Republic of Korea	Ch	eck-be	ox reserved for designating States which have become the PCT after issuance of this sheet.				
	K2	Kazakhatan	<u>~</u> ~						
P,	ecant	langry Designation Statement In 1997	L	• • • •					
Precautionary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(h) all other designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant designation and designation and designation of the supplemental Box as being excluded									
from the scope of this statement. The applicant declares that those additional declares that the scope of this statement. The applicant declares that those additional declares that the scope of this statement.									
AI I	at the expiration of that time limit. (Confirmation fuelfully feet) and reach the experience of the second of the								

Sheet No. 5

Box No. VI PRIORITY CI		Further priority claims are indicated in	n the Supplemental Box
The priority of the following or	rlier application(s) is hereb	y claimed:	
(in which, ar for which, the application was filed)	Filing Date (day/month/year)	Application No.	Office of filing (only for regional or international application)
item (1)	-		
item (2)	• • •		
iem (3)			
The receiving Office is he	rehy requested to prepare a	ation is to be issued by the Office which for the	purposes of the present internationa
Edicad a certified copy o	the earlier application(s) in NAL SEARCHING AUTH	dentified above as item(s):	
Choice of International Search	sing Authority (ISA) ///oue	or manufactural for the state of	
Earlier search Fill in where a sea	rch (international, international	rriy enosen; the two-teller cade may be used); Liype or other) by the International Scarching national secreh, to the extent possible, on the re n (or the translation thereof) or by reference to	Authority has already been carried suits of that earlier search. Identify of the search request:
Box No. VIII CHECK LIST			
This international application the following number of shear		national application is accompanied by the	c item(s) marked below:
	1 1/1/71	separate signed 5. M fee of	calculation sheet ··
4 1.1	- 1 7	copy of general 6. September of attorney	erate indications concerning
4	3112213	determent 1-1-1-	_
_	theets	ack of signature	leouide and/or amino acid ~ Dence listing (diskette) NOSMITTING
Total: 44	·	dentified in Box No. VI 8. Rec	quest for
Pigure No. 1 of the	drawings (if any) should ac	company the abstract when it is published	iority documents
ox No. IX SIGNATURE O	F APPLICANT OR AGE	NT	
		ily in which the person signs (if such capacity is not o	hvious from reading the request).
		iving Office use only	
Date of actual receipt of the international application:	purported	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	2. Drawings
. Corrected date of actual rece untily received papers or dra the purported international a	awings completing		received:
I. Date of timely receipt of the corrections under PCT Artic	required le 11(2);		not received
·			

195/6 'URO/E 198 'ONheet) (January 1994; reprint January 1995)